

Heizspannung	U_f	14	V
Heizstrom	I_f	100	mA

Meßwerte:

Triodenteil

Anodenspannung	U_a	100	170	V
Gittervorspannung	U_g	-1,0	-1,55	V
Anodenstrom	I_a	0,8	1,5	mA
Steilheit	S	1,4	1,65	mA/V
Innenwiderstand	R_i	50	42	k Ω
Verstärkungsfaktor	μ	70	70	

Betriebswerte:

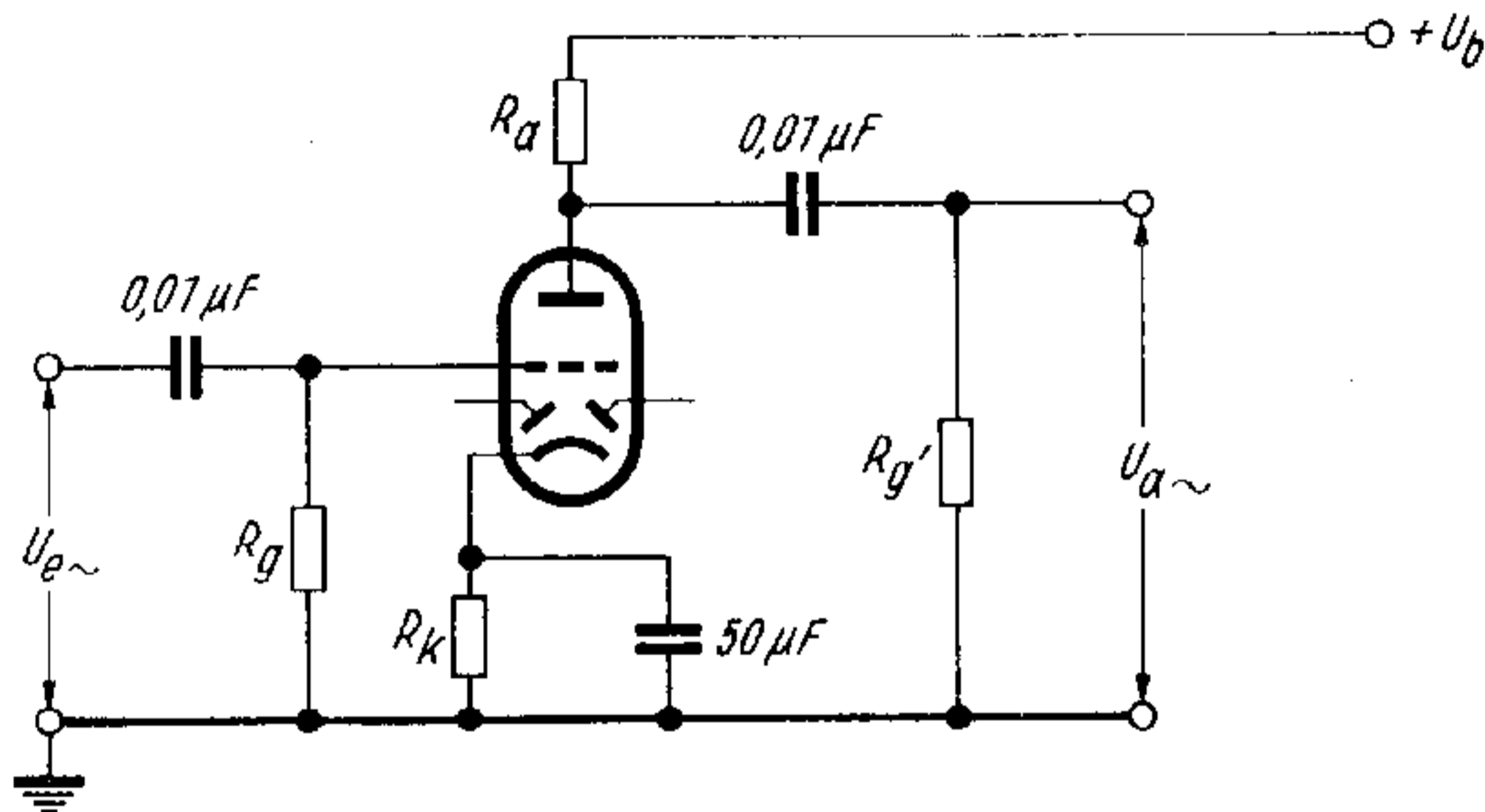
Triode als NF-Verstärker mit Widerstandskopplung

Betriebsspannung	U_b	170	170	170	170	V
Außenwiderstand	R_a	0,1	0,22	0,1	0,22	M Ω
Gitterableitwiderstand	R_g	1	1	22	22	M Ω
Gitterableitwiderstand	R_g'	0,33	0,68	0,33	0,68	M Ω
Kathodenwiderstand	R_k	3900	5600	—	—	Ω
Anodenstrom	I_a	0,45	0,28	0,82	0,46	mA
Spannungsverstärkung	V	37	44	42	48	fach
Klirrfaktor						
bei $U_{a\sim} = 3 V_{eff}$	k	1,1	1,1	0,75	0,95	%
bei $U_{a\sim} = 5 V_{eff}$	k	1,7	1,3	1,0	1,1	%
bei $U_{a\sim} = 8 V_{eff}$	k	2,6	1,85	1,2	1,3	%

Betriebsspannung	U_b	100	100	100	100	V
Außenwiderstand	R_a	0,1	0,22	0,1	0,22	M Ω
Gitterableitwiderstand	R_g	1	1	22	22	M Ω
Gitterableitwiderstand	R_g'	0,33	0,68	0,33	0,68	M Ω
Kathodenwiderstand	R_k	3900	5600	—	—	Ω



Anodenstrom	I_a	0,28	0,18	0,35	0,21	mA
Spannungsverstärkung	V	34	41	35	41	fach
Klirrfaktor						
bei $U_{a\sim} = 3 V_{eff}$	k	2	1,4	1,6	1,45	%
bei $U_{a\sim} = 5 V_{eff}$	k	3,5	1,9	2,8	2,0	%



Grenzwerte:

Anodenkaltspannung	U_{a0}	550	V
Anodenspannung	U_a	250	V
Anodenbelastung	N_a	0,5	W
Gitterableitwiderstand	$R_g^*)$	3	MΩ
Gitterableitwiderstand ($I_g \leq +0,3 \mu A$)	U_{ge}	-1,3	V
Kathodenstrom	I_k	5	mA
Spannung zwischen Faden und Kathode	U_{fk}	150	V
Außenwiderstand zwischen Faden und Kathode	R_{fk}	20	kΩ
Diodenspitzenspannung, je System	U_{dsp}	200	V
Diodenstrom, je System	I_d	0,8	mA
Diodenstromeinsatzpunkt ($I_d \leq +0,3 \mu A$)	U_{de}	-1,3	V

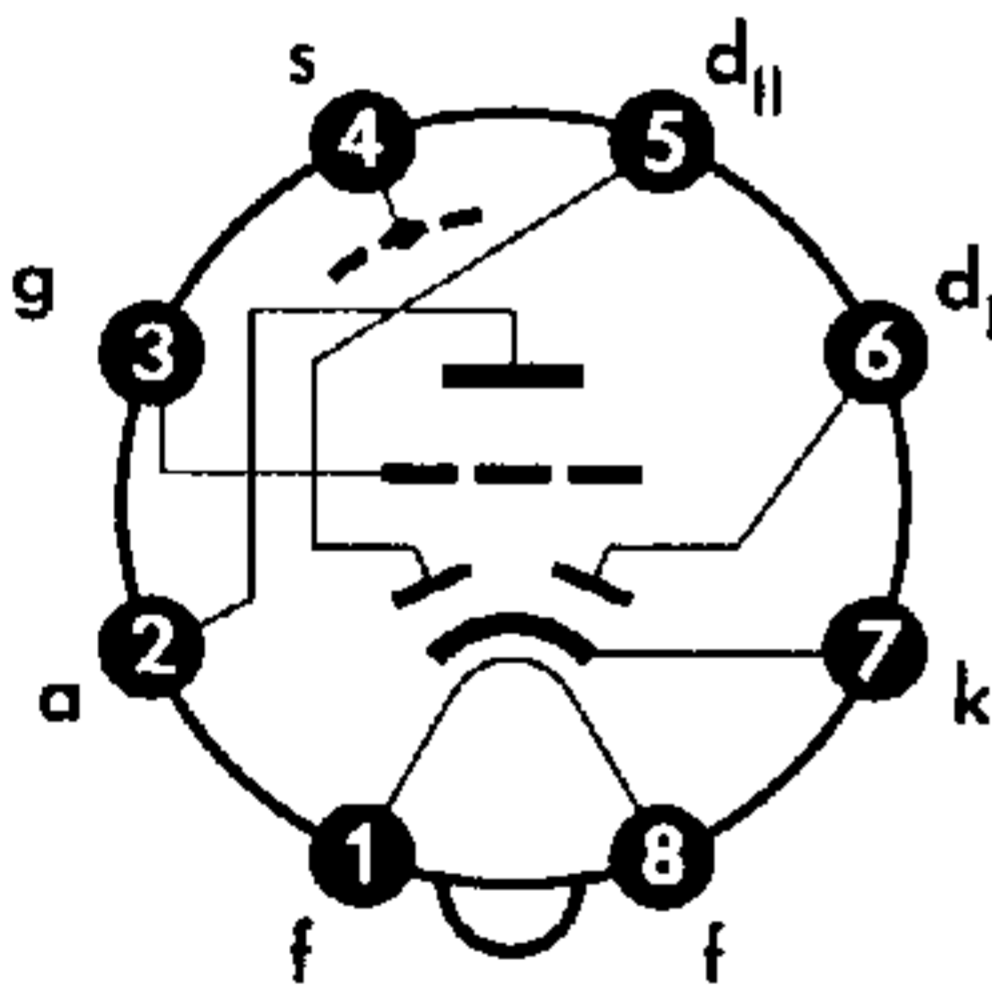
*) Falls die Gittervorspannung nur von einem Gitterableitwiderstand erzeugt wird, darf der Maximalwert von R_g 22 MΩ betragen.



Kapazitäten:

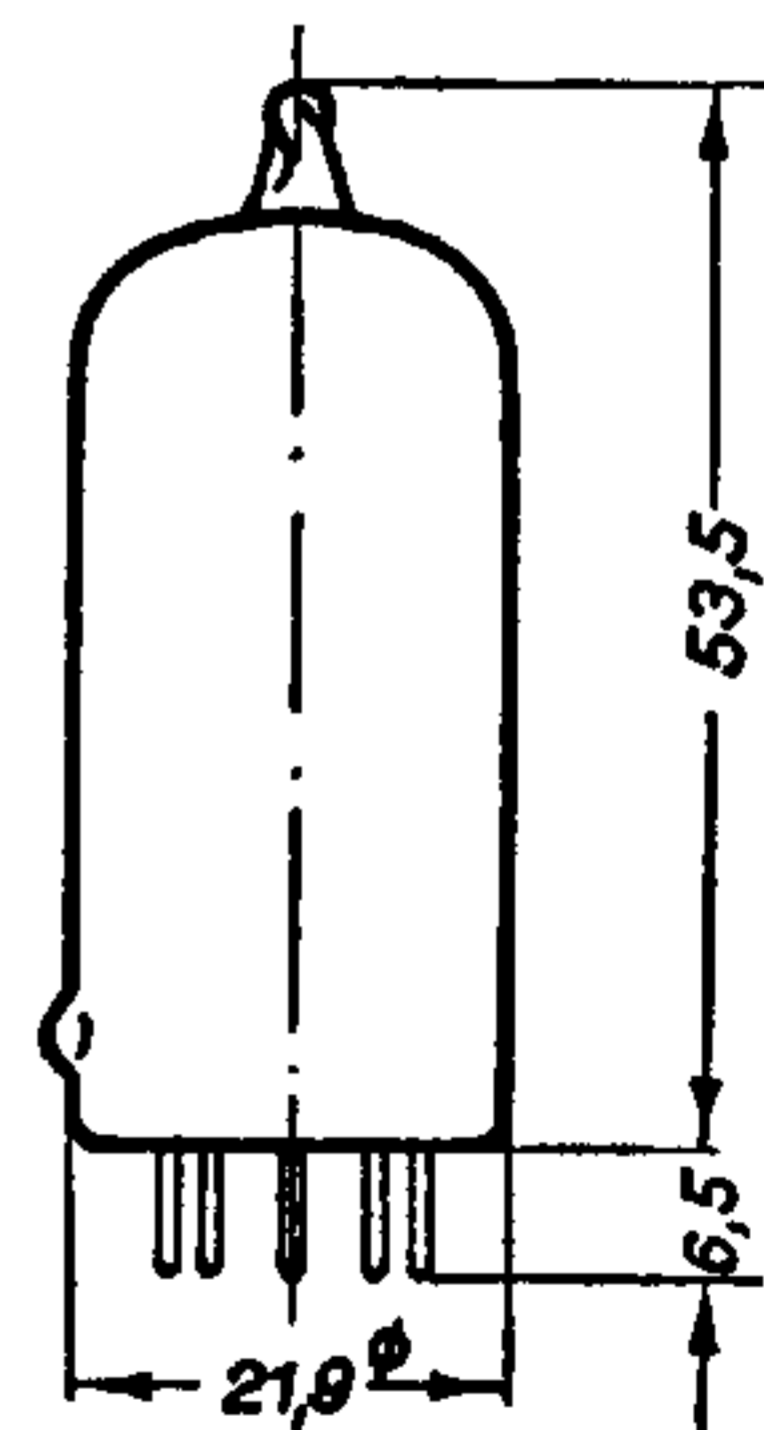
Eingang	C_e	2,7	pF
Ausgang	C_a	1,7	pF
Gitter—Anode	C_{ga}	1,5	pF
Gitter—Faden	C_{gf}	\approx 0,05	pF
Diode I—Kathode	C_{d1k}	0,8	pF
Diode II—Kathode	C_{d11k}	0,7	pF
Diode I—Diode II	C_{d1d11}	\approx 0,3	pF
Diode I—Gitter	C_{d1g}	\approx 0,007	pF
Diode II—Gitter	C_{d11g}	\approx 0,03	pF
Diode I—Anode	C_{d1a}	\approx 0,01	pF
Diode II—Anode	C_{d11a}	\approx 0,01	pF
Diode I—Faden	C_{d1f}	\approx 0,1	pF
Diode II—Faden	C_{d11f}	\approx 0,05	pF

Sockelschaltbild



Pico 8 (Rimlock)

max. Abmessungen



Gewicht: max. 14 g



TELEFUNKEN

